

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2002 - 341367

(P2002 - 341367A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード [*] (参考)
G 0 2 F 1/1343		G 0 2 F 1/1343	2 H 0 9 2
	1/1368		4 M 1 0 4
G 0 9 F 9/00	338	G 0 9 F 9/00	5 C 0 9 4
	342		5 F 0 3 3
	9/30	9/30	5 F 0 4 3
	330		

審査請求 未請求 請求項の数 27 O L (全 21数) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001 - 150092(P2001 - 150092)

(22)出願日 平成13年5月18日(2001.5.18)

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(71)出願人 392026707

秋田日本電気株式会社

秋田県秋田市御所野下堤3丁目1番1号

(72)発明者 前田 明寿

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式
会社内

(74)代理人 100095740

弁理士 開口 宗昭

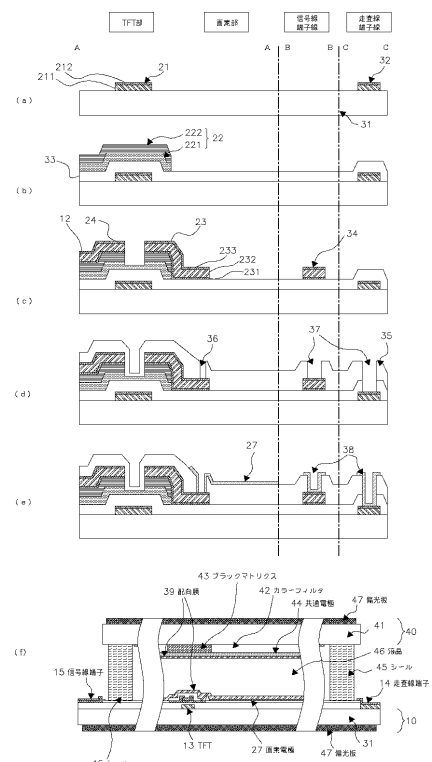
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 製造に際して配線にヒロックが発生せず、かつエッチング形状の制御が容易な液晶表示装置を提供すること。

【解決手段】 本発明の液晶表示装置は、基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置において、前記走査線が下層からアルミニウム - ネオジム合金層と高融点金属層との積層構造からなり、前記信号線が下層から高融点金属層とアルミニウム - ネオジム合金層と高融点金属層との3層構造からなり、高融点金属の種類に応じて、ネオジム含有量を調整することとを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置において、前記走査線が下層からアルミニウム - ネオジム合金層と高融点金属層とを積層した構造からなり、前記信号線が下層から高融点金属層とアルミニウム - ネオジム合金層と高融点金属層とを積層した 3 層構造からなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】 前記高融点金属がクロム、チタン、タンタル及びニオブからなる群から選択される金属、又はクロム、チタン、タンタル及びニオブからなる群から選択される金属を主体とする合金であり、前記アルミニウム - ネオジム合金中のネオジム含有量が 0.01 質量%以上 1 質量%以下であることを特徴とする請求項 1 記載の液晶表示装置。

【請求項 3】 前記高融点金属がモリブデン、タングステン及び窒化チタンからなる群から選択される金属、又はモリブデン、タングステン及び窒化チタンからなる群から選択される金属を主体とする合金であり、前記アルミニウム - ネオジム合金中のネオジム含有量が 0.5 質量%以上 1 質量%以下であることを特徴とする請求項 1 記載の液晶表示装置。

【請求項 4】 基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前記基板上に下層からアルミニウム - ネオジム合金層と高融点金属層とを積層し、当該積層構造をウェットエッチングでパターニングすることにより前記走査線を形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 5】 基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前記基板上に下層から高融点金属層とアルミニウム - ネオジム合金層と高融点金属層とを 3 層に積層して形成し、当該積層構造をウェットエッチングでパターニングすることにより前記信号線を形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 6】 前記高融点金属をモリブデンまたはモリブデンを主体とする合金で形成することを特徴とする請求項 4 又は 5 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 7】 前記走査線または前記信号線のパターニングを燐酸と硝酸と酢酸の混酸によるウェットエッチングで行い、前記混酸の組成を質量%比で、燐酸 72 : 硝酸 4.4 ~ 5.4 : 酢酸 8、または燐酸 74 : 硝酸 4.2 ~ 5.2 : 酢酸 6 とすることを特徴とする請求項 4 ~ 請求項 6 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方

法。

【請求項 8】 前記走査線または前記信号線のパターニングを燐酸と硝酸と酢酸の混酸によるウェットエッチングで行い、前記ウェットエッチングをシャワー処理、もしくはパドル処理またはディップ処理とシャワー処理を組み合わせることを特徴とする請求項 4 ~ 請求項 7 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 9】 基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前記基板上に下層からアルミニウム - ネオジム合金層と高融点金属層とを積層して形成し、当該積層構造を少なくともドライエッチングを含んでパターニングすることにより前記走査線を形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 10】 基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前記基板上に下層から高融点金属層とアルミニウム - ネオジム合金層と高融点金属層とを 3 層に積層して形成し、当該積層構造を少なくともドライエッチングを含んでパターニングすることにより前記信号線を形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 11】 前記高融点金属をクロムまたはクロムを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム - ネオジム合金中のネオジム含有量を 0.01 質量%以上 1 質量%以下に形成することを特徴とする請求項 9 又は 10 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 12】 前記走査線のパターニングを、クロム層またはクロムを主体とする合金層をウェットエッチングで行い、アルミニウム - ネオジム合金層をドライエッチングで順次行うことを特徴とする請求項 9 又は 11 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 13】 前記信号線のパターニングを、上層のクロム層またはクロムを主体とする合金層をウェットエッチングで行い、アルミニウム - ネオジム合金層をウェットエッチングで行い、下層のクロム層またはクロムを主体とする合金層をドライエッチングで順次行うことを特徴とする請求項 10 又は 11 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 14】 前記信号線のパターニング時に信号線上に形成されるマスクとなるフォトレジストの形状を、テーパ角が 30° 以上 55° 以下となるように形成することを特徴とする請求項 13 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 15】 前記ドライエッチングを塩素及び酸素ガス中で行い、下層のクロム層またはクロムを主体とする合金層のエッチングと同時に前記フォトレジストをア

ッシングして後退させることで、上層のクロム層またはクロムを主体とする合金層を後退させることを特徴とする請求項 13 又は 14 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 16】 前記走査線または前記信号線のパターンニングをドライエッチングにより行うことを特徴とする請求項 9～請求項 11 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 17】 前記高融点金属をモリブデンまたはモリブデンを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム - ネオジム合金をネオジム含有量を 0.5 質量%以上 1 質量%以下に形成することを特徴とする請求項 9 又は 10 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 18】 前記信号線のパターンニングを、上層のモリブデン層またはモリブデンを主体とする合金層をウェットエッチングで行い、アルミニウム - ネオジム合金層を途中までウェットエッチングで行い、残りのアルミニウム - ネオジム合金層と下層のモリブデン層またはモリブデンを主体とする合金層とをドライエッチングで順次行うことを特徴とする請求項 10 又は 17 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 19】 前記走査線または前記信号線のパターンニングをドライエッチングにより行うことを特徴とする請求項 9、10 又は 17 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 20】 前記高融点金属をチタン、タンタル、ニオブの何れか、またはチタン、タンタル、ニオブの何れかを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム - ネオジム合金中のネオジム含有量を 0.01 質量%以上 1 質量%以下に形成することを特徴とする請求項 9 又は 10 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 21】 前記高融点金属をタングステン、窒化チタンの何れか、またはタングステン、窒化チタンの何れかを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム - ネオジム合金中のネオジム含有量を 0.5 質量%以上 1 質量%以下に形成することを特徴とする請求項 9 又は 10 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 22】 前記走査線または前記信号線のパターンニングをドライエッチングにより行うことを特徴とする請求項 9、10、20 又は 21 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 23】 前記画素電極を透明導電膜で形成し、前記透明導電膜のパターンニングをシュウ酸によるウェットエッチングにより行うことを特徴とする請求項 4～請求項 22 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 24】 前記透明導電膜をインジウム錫酸化膜で形成し、前記インジウム錫酸化膜の成膜を非加熱かつ水を含有させた不活性ガス中で行い、その際の水の分圧を 2×10^{-3} p a 以上 5×10^{-2} p a 以下とすることを*

*特徴とする請求項 23 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 25】 前記透明導電膜をインジウム亜鉛酸化膜で形成することを特徴とする請求項 23 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 26】 前記薄膜トランジスタのソース、ドレイン電極を形成する際の不純物半導体層のパターンニングをフッ素系ガスもしくはフッ素系ガスと塩酸を除く塩素系ガスによるドライエッチングにより行うことを特徴とする請求項 4～請求項 25 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 27】 前記薄膜トランジスタのソース、ドレイン電極を形成する際の不純物半導体層のパターンニング及び前記薄膜トランジスタの半導体層のパターンニングを、フッ素系ガスもしくはフッ素系ガスと塩酸を除く塩素系ガスによるドライエッチングにより行うことを特徴とする請求項 4～請求項 25 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置及びその製造方法に関するものであり、更に詳細には、配線のパターンニングが容易でヒロックの発生のないアクティブマトリックス基板を容易に製造することのできる液晶表示装置及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来の液晶表示装置に用いられるアクティブマトリックス基板は、成膜とマスクを用いたフォトリソグラフィ、エッチング工程とを繰り返して製造される。この際、生産コストを低減させるためにはマスクの数を少なくするのが好ましく、一般的に、5 枚又は 4 枚のマスクが用いられている。5 枚のマスクを用いてアクティブマトリックス基板を製造する方法としては、例えば、特開平9-171197号公報及び特開平9-197433号公報に開示されたものが知られている。また、4 枚のマスクを用いてアクティブマトリックス基板を製造する方法としては、例えば、特開2000-164886号公報に開示された方法が知られている。

【0003】また、アルミニウム (A1) はパターンニングが容易で、基板との密着性に優れ、低比抵抗かつ低応力な配線、電極材料であり、アクティブマトリックス基板の製造に広く用いられている。しかし、融点が高いために配線パターン形成後の CVD プロセス、アニールプロセス等の加熱処理によるヒロックが発生し、走査線と信号線間で耐圧不良等が発生しやすい。このようなヒロック発生を抑制するため、アクティブマトリックス基板の配線、電極材料として、特にアルミニウムネオジム (A1 - Nd) 合金が広く用いられている。前述したような、5 枚又は 4 枚のマスクを用いてアクティブマトリックス基板を製造する方法において、走査線や信号線に

A1配線を適用する場合には、一般的に、A1と透明導電膜や半導体層とを電氣的に接続する際のバリアメタルとなる高融点金属をアルミニウムとの2層又は3層に積層した配線が用いられる。

【0004】アクティブマトリックス基板の配線にA1-Nd合金を用いる技術は、例えば、特開2000-275679号公報、特開2000-47240号公報、特開2000-314897号公報に開示された技術が知られている。特開2000-275679号公報には、ゲート電極がA1-Nd合金とその上に高融点金属を積層した積層構造の液晶表示装置が示されている。これによりヒロックの抑制とパターニングプロセスの簡略化が可能となる。A1-Nd合金と高融点金属の積層膜のエッチングにはウェットエッチングが用いられている。また、特開2000-47240号公報には、走査線と信号線の少なくとも一方に、Nd含有量が1~4.5質量%の範囲のA1-Nd合金を用い、配線端部の形状のテーパ角を40°~55°にした液晶表示装置が示されている。これにより、下部配線の段差上での絶縁膜の被覆をよくし、上部配線と下部配線のショート等の不良を低減が可能となる。ここでは、A1-Nd合金及びA1-Nd合金と高融点金属の2層構造の積層膜のエッチングには、それぞれウェットエッチングが用いられている。高融点金属とA1-Nd合金と高融点金属の3層構造の積層膜のエッチング方法については、何も述べられていない。また、特開2000-314897号公報には、配線が下層から順に積層する高融点金属とA1またはA1合金の2層構造、もしくは高融点金属とA1またはA1合金と高融点金属の3層構造であり、A1またはA1合金の側面がアルミナ層で被覆されている液晶表示装置が示されている。これによりヒロックの抑制とパターニングプロセスの簡略化が可能となる。ここでは、高融点金属は純Cr、Cr合金、純Mo、Mo合金に限定される。また、A1合金はTi、Ta、Nd、Y、La、Sm、Siの1種以上を0.1~1原子%含んでいる。高融点金属とA1-Nd合金の2層構造の積層膜及び高融点金属とA1-Nd合金と高融点金属の3層構造の積層膜のエッチングには、それぞれウェットエッチングが用いられている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】前述した従来の特開2000-275679号公報、特開2000-47240号公報、特開2000-314897号公報のように、A1(合金)と高融点金属との積層配線のパターニングをウェットエッチングで行うとA1配線が溶かされて配線形状の制御が困難である。従って、A1と高融点金属との積層配線のパターニングにはドライエッチングが用いられるのが一般的である。しかし、配線材料としてヒロック抑制のために、特にNd濃度を上げたA1-Nd合金を用いた場合、ドライエッチングを用いると、エッチング残渣が発生するため、パターニングが困難になり、短縮プロセスを採用したアクテ

ィブマトリックス基板への適用が困難であるという問題がある。一方、ウェットエッチングを用いると、高融点金属としてクロム(Cr)を用いた場合、下層のA1やCrにサイドエッチが入りやすく、また、高融点金属としてモリブデン(Mo)を用いた場合にも、下層のA1やMoにサイドエッチが入りやすくなり、一括エッチングを行うことは困難である。

【0006】更に、上記の特開平9-171197号公報、特開平9-197433号公報、特開2000-164886号公報のようなパッシベーション膜上に画素電極を形成する逆スタガ型の薄膜トランジスタアレイ基板では、信号線にA1配線を用いた場合、画素電極となる透明導電膜のエッチングを王水やヨウ化水素、塩化鉄系等のエッチング液を用いて行くと、パッシベーション膜の欠陥部からエッチング液がしみ込み、A1配線を溶かしてしまい、信号線の断線が発生しやすくなる。前述した特開2000-314897号公報では、A1(合金)層の側面がアルミナ層で被覆されているため、この問題は緩和されるが、A1(合金)の酸化のためのペーマイト処理が必要となり、工程数が増える。また、エッチング液のしみ込みは上層の高融点金属膜の柱状結晶構造の結晶粒界を通しても起こるので信号線の断線が完全に抑制できない。信号線の断線を防止するためには、通常A1を侵さないシュウ酸によるエッチングが行われている。シュウ酸を用いてエッチングを行う場合は、残渣の発生を防止するため、透明導電膜(インジウム錫酸化膜:ITO)の成膜は、非加熱でかつ水(H₂O)を含有させて行う必要があるが、水を含有させると透明導電膜と下層の金属膜とのコンタクト抵抗が増大するという問題がある。

【0007】従って、アクティブマトリックス基板の製造に際して、配線形状の制御が容易で、信号線の断線や透明導電膜と下層の金属膜とのコンタクト抵抗の増大を抑制できる低抵抗配線及び短縮プロセスを適用したアクティブマトリックス基板の製造方法が望まれていた。

【0008】本発明の目的は、製造に際して配線にヒロックが発生せず、エッチング残渣が少なく、配線形状の制御が容易でかつ信号線の断線や透明導電膜と下層の金属膜とのコンタクト抵抗の増大を抑制できるアクティブマトリックス基板を用いた液晶表示装置及びその製造方法を提供することである。

【0009】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため、本出願の請求項1に記載の発明の液晶表示装置は、基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置において、前記走査線が下層からアルミニウム-ネオジム合金層と高融点金属層との積層構造からなり、前記信号線が下層から高融点金属層とアルミニウム-ネオジム合金層と高融点金属層との3層構造からな

ることを特徴としている。

【0010】また、本出願の請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の液晶表示装置において、前記高熔点金属がクロム、チタン、タンタル及びニオブからなる群から選択される金属、又はクロム、チタン、タンタル及びニオブからなる群から選択される金属を主体とする合金であり、前記アルミニウム - ネオジム合金中のネオジム含有量が0.01質量%以上1質量%以下であることを特徴としている。

【0011】また、本出願の請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の液晶表示装置において、前記高熔点金属がモリブデン、タングステン及び窒化チタンからなる群から選択される金属、又はモリブデン、タングステン及び窒化チタンからなる群から選択される金属を主体とする合金であり、前記アルミニウム - ネオジム合金中のネオジム含有量が0.5質量%以上1質量%以下であることを特徴としている。かかる構成とすることにより、配線にヒロックが発生せず、エッチング形状制御の容易な液晶表示装置となる。

【0012】また、本出願の請求項4に記載の発明の液晶表示装置の製造方法は、基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前記基板上に下層からアルミニウム - ネオジム合金層と高熔点金属層とを積層し、当該積層構造をウェットエッチングでパターニングすることにより前記走査線を形成することを特徴としている。

【0013】また、本出願の請求項5に記載の発明の液晶表示装置の製造方法は、基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前記基板上に下層から高熔点金属層とアルミニウム - ネオジム合金層と高熔点金属層とを3層に積層して形成し、当該積層構造をウェットエッチングでパターニングすることにより前記信号線を形成することを特徴としている。

【0014】また、本出願の請求項6に記載の発明は、請求項4又は5に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記高熔点金属をモリブデンまたはモリブデンを主体とする合金で形成することを特徴としている。

【0015】また、本出願の請求項7に記載の発明は、請求項4～請求項6のいずれか1項に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記走査線または前記信号線のパターニングを燐酸と硝酸と酢酸の混酸によるウェットエッチングで行い、前記混酸の組成を質量%比で、燐酸72：硝酸4.4～5.4：酢酸8、または燐酸74：硝酸4.2～5.2：酢酸6とすることを特徴としている。

【0016】また、本出願の請求項8に記載の発明は、請求項4～請求項7のいずれか1項に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記走査線または前記信号線のパターニングを燐酸と硝酸と酢酸の混酸によるウェットエッチングで行い、前記ウェットエッチングをシャワー処理、もしくはパドル処理またはディップ処理とシャワー処理を組み合わせることを特徴としている。かかる構成とすることにより、高熔点金属にモリブデンまたはモリブデンを主体とする合金を用いた場合、エッチング形状制御の容易な液晶表示装置を製造することができる。

【0017】また、本出願の請求項9に記載の発明の液晶表示装置の製造方法は、基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前記走査線を下層からアルミニウム - ネオジム合金層と高熔点金属層とを積層して形成し、前記走査線のパターニングを少なくともドライエッチングを含んで行うことを特徴としている。

【0018】また、本出願の請求項10に記載の発明の液晶表示装置の製造方法は、基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前記信号線を下層から高熔点金属層とアルミニウム - ネオジム合金層と高熔点金属層とを3層に積層して形成し、前記信号線のパターニングを少なくともドライエッチングを含んで行うことを特徴としている。

【0019】また、本出願の請求項11に記載の発明は、請求項9又は10に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記高熔点金属をクロムまたはクロムを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム - ネオジム合金中のネオジム含有量を0.01質量%以上1質量%以下に形成することを特徴としている。

【0020】また、本出願の請求項12に記載の発明は、請求項9又は11に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記走査線のパターニングを、クロム層またはクロムを主体とする合金層をウェットエッチングで行い、アルミニウム - ネオジム合金層をドライエッチングで順次行うことを特徴としている。

【0021】また、本出願の請求項13に記載の発明は、請求項10又は11に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記信号線のパターニングを、上層のクロム層またはクロムを主体とする合金層をウェットエッチングで行い、アルミニウム - ネオジム合金層をウェットエッチングで行い、下層のクロム層またはクロムを主体とする合金層をドライエッチングで順次行うことを特徴としている。

【0022】また、本出願の請求項14に記載の発明

は、請求項 13 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記信号線のパターニング時に信号線上に形成されるマスクとなるフォトレジストの形状を、テーパ角が 30° 以上 55° 以下となるように形成することを特徴としている。

【0023】また、本出願の請求項 15 に記載の発明は、請求項 13 又は 14 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記ドライエッチングを塩素及び酸素ガス中で行い、下層のクロム層またはクロムを主体とする合金層のエッチングと同時に前記フォトレジストをアッシングして後退させ、上層のクロム層またはクロムを主体とする合金層も後退させることを特徴としている。

【0024】また、本出願の請求項 16 に記載の発明は、請求項 9 ~ 請求項 11 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記走査線または前記信号線のパターニングをドライエッチングにより行うことを特徴としている。かかる構成とすることにより、高融点金属にクロムまたはクロムを主体とする合金を用いた場合、配線にヒロックが発生せず、エッチング残渣が少なく、かつ形状制御の容易な液晶表示装置を製造することができる。

【0025】また、本出願の請求項 17 に記載の発明は、請求項 9 又は 10 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記高融点金属をモリブデンまたはモリブデンを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム - ネオジム合金をネオジム含有量を 0.5 質量%以上 1 質量%以下に形成することを特徴としている。

【0026】また、本出願の請求項 18 に記載の発明は、請求項 10 又は 17 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記信号線のパターニングを、上層のモリブデン層またはモリブデンを主体とする合金層をウェットエッチングで行い、アルミニウム - ネオジム合金層を途中までウェットエッチングで行い、残りのアルミニウム - ネオジム合金層と下層のモリブデン層またはモリブデンを主体とする合金層とをドライエッチングで順次行うことを特徴としている。

【0027】また、本出願の請求項 19 に記載の発明は、請求項 9、10 又は 17 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記走査線または前記信号線のパターニングをドライエッチングにより行うことを特徴としている。かかる構成とすることにより、高融点金属にモリブデンまたはモリブデンを主体とする合金を用いた場合、配線にヒロックが発生せず、エッチング残渣が少なく、かつ形状制御の容易な液晶表示装置を製造することができる。

【0028】また、本出願の請求項 20 に記載の発明は、請求項 9 又は 10 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記高融点金属をチタン、タンタル、ニオブの何れかまたはチタン、タンタル、ニオブの何れかを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム - ネオジム合

金中のネオジム含有量を 0.01 質量%以上 1 質量%以下に形成することを特徴としている。

【0029】また、本出願の請求項 21 に記載の発明は、請求項 9 又は 10 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記高融点金属をタングステン、窒化チタンの何れか、またはタングステン、窒化チタンの何れかを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム - ネオジム合金中のネオジム含有量を 0.5 質量%以上 1 質量%以下に形成することを特徴としている。

【0030】また、本出願の請求項 22 に記載の発明は、請求項 9、10、20 又は 21 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記走査線または前記信号線のパターニングをドライエッチングにより行うことを特徴としている。かかる構成とすることにより、高融点金属にチタン、タンタル、ニオブ、タングステン、窒化チタンの何れか、またはチタン、タンタル、ニオブ、タングステン、窒化チタンの何れかを主体とする合金を用いた場合、配線にヒロックが発生せず、エッチング残渣が少なく、かつ形状制御の容易な液晶表示装置を製造することができる。

【0031】また、本出願の請求項 23 に記載の発明は、請求項 4 ~ 請求項 22 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記画素電極を透明導電膜で形成し、前記透明導電膜のパターニングをシュウ酸によるウェットエッチングで行うことを特徴としている。

【0032】また、本出願の請求項 24 に記載の発明は、請求項 23 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記透明導電膜をインジウム錫酸化膜で形成し、前記インジウム錫酸化膜の成膜を非加熱かつ水を含有させた不活性ガス中で行い、その際の水の分圧を 2×10^{-3} Pa 以上 5×10^{-2} Pa 以下とすることを特徴としている。

【0033】また、本出願の請求項 25 に記載の発明は、請求項 23 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記透明導電膜をインジウム亜鉛酸化膜で形成することを特徴としている。かかる構成とすることにより、信号線の断線が低減でき、透明導電膜の残渣がなく、かつ透明導電膜と下層の金属膜とのコンタクト抵抗の増大を防止し得る液晶表示装置を製造することができる。

【0034】また、本出願の請求項 26 に記載の発明は、請求項 4 ~ 請求項 25 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記薄膜トランジスタのソース、ドレイン電極を形成する際の不純物半導体層のパターニングをフッ素系ガスもしくはフッ素系ガスと塩酸を除く塩素系ガスによるドライエッチングにより行うことを特徴としている。

【0035】また、本出願の請求項 27 に記載の発明は、請求項 4 ~ 請求項 25 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記薄膜トランジスタの

ソース、ドレイン電極を形成する際の不純物半導体層のパターニング及び前記薄膜トランジスタの半導体層のパターニングを、フッ素系ガスもしくはフッ素系ガスと塩酸を除く塩素系ガスによるドライエッチングにより行うことを特徴としている。かかる構成とすることにより、信号線の腐食を防止し得る液晶表示装置を製造することができる。

【0036】以上のように、本発明は、Al-Nd合金と高融点金属との積層配線を用いた逆スタガ型薄膜トランジスタアレイ基板を有する液晶表示装置及びその製造方法において、高融点金属の種類に応じてNd濃度を調整することにより、ヒロックとエッチング残渣の発生を共に抑制しつつ、同時に配線形状の制御を容易に行うことが可能となる。

【0037】

【発明の実施の形態】以下、本発明の液晶表示装置について図面を参照して説明する。図1は本発明の液晶表示装置に使用する薄膜トランジスタアレイ基板(TFT基板)の構成を示す概念図である。図1に示すように、TFT基板10には、透明絶縁性基板上に複数の走査線11と複数の信号線12とがほぼ直交して配設され、その交点近傍にこれらに接続されてスイッチング素子である薄膜トランジスタ(TFT)13が設けられ、これらがマトリクス状に配置されている。また、走査線11の端部にはアドレス信号を入力する走査線端子14が、信号線12の端部にはデータ信号を入力する信号線端子15がそれぞれ設けられている。

【0038】次に、本発明の液晶表示装置の第1の実施形態の構成について説明する。図2は、本発明の第1の実施形態の液晶表示装置に使用するTFT基板の1画素部及び走査線端子部、信号線端子部の平面図であり、図3は図2のA-A線、B-B線及びC-C線に沿って切って図示した断面図であり、本発明の液晶表示装置において用いられるTFT基板の製造工程を図示したものである。なお、第1の実施形態は5枚のマスクを用いて製造される逆スタガチャネルエッチ型TFT基板を有する液晶表示装置の例である。図2及び図3(e)に示したTFT基板は、透明絶縁性基板31上にゲート電極21と、ゲート電極21に接続する走査線11と、前段の走査線を共有する蓄積容量電極25と、遮光層26と、走査線端子14の下層金属膜32とが形成されており、ゲート電極21上にはゲート絶縁膜33が設けられ、ゲート絶縁膜33上にゲート電極21と対向して半導体層22が設けられ、半導体層22上にソース電極23及びドレイン電極24が分離されて形成されている。また、ソース電極23と、ドレイン電極24と、ゲート絶縁膜33上に設けられたドレイン電極24に接続する信号線12と、信号線端子15の下層金属膜34との上にはパッシベーション膜35が設けられており、パッシベーション膜35の一部に画素部コンタクトホール36と端子部

コンタクトホール37が設けられている。このコンタクトホール36、37を介して、ソース電極23に接続する画素電極27と端子部の下層金属膜32、34に接続する接続電極38が設けられている。ここで、蓄積容量電極25と画素電極27との間で保持容量が形成されている。

【0039】また、図3(e)に示すように、本発明の液晶表示装置に用いられるTFT基板においては、ゲート電極21、走査線11(図示せず)が下層からAl-Nd合金層211と高融点金属層212との積層構造からなっている。また、ソース電極23及びドレイン電極24、信号線12は、下層から高融点金属層231とAl-Nd合金層232と高融点金属層233との積層構造からなっている。

【0040】本発明の液晶表示装置に用いられるTFT基板に用いられる高融点金属は、クロム(Cr)、チタン(Ti)、タンタル(Ta)、ニオブ(Nb)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)及びそれらを含む合金からなる群から選択される。高融点金属がチタンである場合は、高融点金属層は窒化チタン(TiN)から構成されてもよい。

【0041】本発明の液晶表示装置に用いられるTFT基板におけるAl-Nd合金中のNd含有量はヒロック防止とエッチング性の観点から最適値に調整する必要があり、高融点金属の種類に依存するものである。即ち、高融点金属としてCr、Ti、Ta、Nbの何れか又はこれらの何れかを主体とする合金を用いた場合は、Al-Nd合金中のネオジム含有量は0.01~1質量%であることが望ましい。また、高融点金属としてMo、W、TiNの何れか又はこれらの何れかを主体とする合金を用いた場合は、Al-Nd合金中のネオジム含有量は0.5~1質量%であることが望ましい。前述したTFT基板は、容易にパターニングすることができるものであり、得られたTFT基板はヒロックの発生のないものである。

【0042】次に、本発明の液晶表示装置の第2の実施形態の構成について説明する。図4は、本発明の第2の実施形態の液晶表示装置に使用するTFT基板の1画素部及び走査線端子部、信号線端子部の平面図であり、図5は図4のA-A線、B-B線及びC-C線に沿って切って図示した断面図であり、本発明の液晶表示装置において用いられるTFT基板の製造工程を図示したものである。なお、第2の実施形態は4枚のマスクを用いて製造される逆スタガチャネルエッチ型TFT基板を有する液晶表示装置の例である。

【0043】図4及び図5(d)に示したTFT基板は、透明絶縁性基板31上にゲート電極21と、ゲート電極21に接続する走査線11と、前段の走査線を共有する蓄積容量電極25と、遮光層26と、走査線端子14の下層金属膜32とが形成されており、ゲート電極2

1 上にはゲート絶縁膜 33 が設けられており、ゲート絶縁膜 33 上にゲート電極 21 と対向して半導体層 22 が設けられ、半導体層 22 上にソース電極 23 及びドレイン電極 24 が分離されて形成されている。第 1 の実施形態と異なるのは、ソース電極 23 及びドレイン電極 24 が半導体層 22 上に形成され、それぞれの端面が一致していることである。また、ソース電極 23 と、ドレイン電極 24 と、ゲート絶縁膜 33 上に設けられたドレイン電極 24 に接続する信号線 12 と、信号線端子部の金属膜 34 の上にはパッシベーション膜 35 が設けられており、パッシベーション膜 35 の一部に画素部コンタクトホール 36 と端子部コンタクトホール 37 が設けられている。このコンタクトホール 36、37 を介して、ソース電極 23 に接続する画素電極 27 と端子部の下層金属膜 32、34 に接続する接続電極 38 が設けられている。ここで、蓄積容量電極 25 と画素電極 27 との間で保持容量が形成されている。

【0044】また、図 5 (d) に示すように、本発明の液晶表示装置に用いられる TFT 基板においては、ゲート電極 21、走査線 11 (図示せず) が下層から Al - Nd 合金層 211 と高融点金属層 212 との積層構造からなっている。また、ソース電極 23 及びドレイン電極 24、信号線 12 は、下層から高融点金属層 231 と Al - Nd 合金層 232 と高融点金属層 233 との積層構造からなっている。第 2 の実施形態の構成について、他の点は第 1 の実施形態において説明したのと同様である。

【0045】次に、本発明の液晶表示装置の第 3 の実施形態の構成について説明する。図 7 は、本発明の第 3 の実施形態の液晶表示装置に使用する TFT 基板の 1 画素部及び走査線端子部、信号線端子部の平面図であり、図 8 は図 7 の A - A 線、B - B 線及び C - C 線に沿って切って図示した断面図であり、本発明の液晶表示装置において用いられる TFT 基板の製造工程を図示したものである。なお、第 2 の実施形態は 5 枚のマスクを用いて製造される逆スタガチャネル保護型 TFT 基板を有する液晶表示装置の例である。

【0046】図 7 及び図 8 (e) に示した TFT 基板は、透明絶縁性基板 31 上にゲート電極 21 と、ゲート電極 21 に接続する走査線 11 と、前段の走査線を共有する蓄積容量電極 25 と、遮光層 26 と、走査線端子 14 の下層金属膜 32 とが形成されており、ゲート電極 21 上にはゲート絶縁膜 33 が設けられており、ゲート絶縁膜 33 上にゲート電極 21 と対向して半導体層 22 とチャネル保護膜 71 が設けられ、この上にソース電極 23 及びドレイン電極 24 が分離されて形成されている。チャネル保護膜が形成されていることが第 2 の実施形態と異なる。また、ソース電極 23 と、ドレイン電極 24 と、ゲート絶縁膜 33 上に設けられたドレイン電極 24 に接続する信号線 12 と、信号線端子 15 部の下層金属

膜 34 の上にはパッシベーション膜 35 が設けられており、パッシベーション膜 35 の一部に画素部コンタクトホール 36 と端子部コンタクトホール 37 が設けられている。このコンタクトホール 36、37 を介して、ソース電極 23 に接続する画素電極 27 と端子部の下層金属膜 32、34 に接続する接続電極 38 が設けられている。ここで、蓄積容量電極 25 と画素電極 27 との間で保持容量が形成されている。

【0047】また、図 8 (e) に示すように、本発明の液晶表示装置に用いられる TFT 基板においては、ゲート電極 21、走査線 11 (図示せず) が下層から Al - Nd 合金層 211 と高融点金属層 212 との積層構造からなっている。また、ソース電極 23 及びドレイン電極 24、信号線 12 は、下層から高融点金属層 231 と Al - Nd 合金層 232 と高融点金属層 233 との積層構造からなっている。第 3 の実施形態の構成について、他の点は第 1 の実施形態において説明したのと同様である。

【0048】次に、本発明の液晶表示装置の製造方法について、図面を参照して詳細に説明する。まず、本発明の第 1 の実施形態の液晶表示装置に用いられる TFT 基板の製造方法は、(1) 透明絶縁性基板上にゲート電極及び走査線を形成する工程、(2) ゲート絶縁膜、半導体層を形成する工程、(3) ソース、ドレイン電極及び信号線を形成する工程、(4) パッシベーション膜、コンタクトホールを形成する工程、(5) 画素電極を形成する工程を有し、前記ゲート電極及び走査線を Al - Nd 合金層と高融点金属層との積層構造に形成し、前記ソース、ドレイン電極及び信号線を高融点金属層と Al - Nd 合金層と高融点金属層との 3 層構造に形成することを特徴とする。

【0049】本発明の液晶表示装置において用いられる TFT 基板の製造方法の第 1 の実施例は、図 3 に示すように、まず、厚さ 0.7 mm の無アルカリガラスからなる透明絶縁性基板 31 上に、スパッタにより厚さ約 200 nm の Al - Nd 合金層 211 と厚さ約 100 nm の高融点金属層 212 を成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、ゲート電極 21、走査線 (図示せず)、蓄積容量電極 (図示せず)、遮光層 (図示せず)、走査線端子部の下層金属膜 32 を形成する (図 3 (a))。ここで、高融点金属は、Cr、Ti、Ta、Nb の何れか及びこれらの何れかの合金からなる群と、Mo、W、TiN の何れか及びこれらの何れかの合金からなる群から選択される。前者の群から選択する場合は、Al - Nd 合金の Nd 含有量は 0.01 ~ 1 質量% に調整し、後者の群から選択する場合は、Al - Nd 合金の Nd 含有量は 0.5 ~ 1 質量% に調整する。エッチングの方法については後述する。

【0050】次に、プラズマ CVD により厚さ約 400 nm のシリコン窒化膜からなるゲート絶縁膜 33 と厚さ

約200nmのアモルファスシリコン(a-Si)層221と厚さ約30nmのリンをドーブしたN型アモルファスシリコン(n+a-Si)層222とを順次成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより、半導体層22を形成する(図3(b))。

【0051】次に、スパッタにより厚さ約50nmの高融点金属層231と厚さ200nmのAl-Nd合金層232と厚さ約100nmの高融点金属層233を順次成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより、ソース電極23、ドレイン電極24、信号線12、信号線端子部の下層金属膜34を形成する(図3(c))。ここで、高融点金属とAl-Nd合金のNd含有量については、前述した通りである。次に、ソース電極23とドレイン電極24との間のn+a-Si層222をエッチングして除去する。このエッチングは、ソース、ドレイン電極形成時のフォトレジストをマスクにして行ってもよいし、フォトレジストを剥離した後、ソース、ドレイン電極をマスクにして行ってもよい。エッチングの方法は、例えば、6フッ化硫黄(SF₆)と塩素(Cl₂)と水素(H₂)との混合ガスによるエッチングや3フッ化メタン(CHF₃)と酸素(O₂)とヘリウム(He)の混合ガスとSF₆とHeの混合ガスによる2ステップエッチング等、フッ素系ガス又はフッ素系ガスと塩酸(HCl)を除く塩素系ガスにより行われる。エッチングはプラズマエッチ(PEモード)でもリアクティブイオンエッチ(RIEモード)でもどちらで行ってもよい。HClを用いないことにより、Al-Nd合金のコロージョンを防止することができるとわかった。走査線と信号線のエッチング方法については後述する。

【0052】次に、プラズマCVDにより厚さ約200nmのシリコン窒化膜からなるパッシベーション膜35を成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより、画素部コンタクトホール36及び端子部コンタクトホール37を開口する(図3(d))。

【0053】次に、スパッタにより厚さ約50nmのITOまたはインジウム亜鉛酸化膜(IZO)からなる透明導電膜を成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより、画素電極27及び端子部の接続電極38を形成する(図3(e))。透明導電膜のエッチングはシュウ酸を用いて行う。これにより、パッシベーション膜の欠陥部や下地段差部での被覆不良部からエッチング液がしみ込んで、ソース、ドレイン電極や信号線のAl-Nd合金層を侵すことがなく、断線不良を低減できる。また、透明導電膜がITOである場合、成膜は次のように行う。一端真空に引いたスパッタ装置の成膜チャンバーにアルゴン(Ar)と酸素と同時に、水をその分圧が2×10⁻³Pa~5×10⁻²Paになるように導入し、DCマグネトロンスパッタによりITOを成膜する。このとき基板加熱は行わず、常温で成膜する。これにより、シュウ酸でのエッチングが可能になり、かつ透明導電膜

と下層金属膜とのコンタクト抵抗の増大を抑制することができる。この点については後述する。最後に、約270℃の温度でアニールし、TFT基板を完成する。

【0054】以下、走査線と信号線のエッチング方法について詳細に説明する。まず、高融点金属としてCr又はCrを主体とする合金を用いた場合について説明する。図9及び図10は、高融点金属としてCr又はCrを主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、図9は走査線を、図10は信号線を形成する工程を示す図である。

【0055】まず、走査線の形成方法について図9を参照して説明する。透明絶縁性基板31上に積層されたAl-Nd合金層91(Nd含有量0.01%~1質量%)及び高融点金属層(Cr層)92上に、フォトレジスト93を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト93を所定のパターンにパターニングし(図9(a))、このフォトレジスト93をマスクとしてCr層92をウェットエッチングする(図9(b))。エッチング液には、例えば、硝酸セリウム第2アンモニウムと硝酸の混酸を用い、常温で行う。ウェットエッチングの方法としては特に制限はなく、シャワー処理あるいはディップ処理により実施することができる。次いで、Al-Nd合金層91をドライエッチングする(図9(c))。エッチングガスとしては、塩素(Cl₂)と3塩化ホウ素(BCl₃)を用い、例えば、圧力1.3Pa、Cl₂流量60sccm、BCl₃流量20sccm、電極間距離150mmの条件で、RIEを行う。最後に、フォトレジスト93を剥離除去し、走査線94(11)を形成した(図9(d))。

【0056】次に、信号線の形成方法について図10を参照して説明する。ゲート絶縁膜33上に積層された高融点金属層(Cr層)101、Al-Nd合金層102及び高融点金属層(Cr層)103上に、フォトレジスト104を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト104を所定のパターンにパターニングし(図10(a))、このフォトレジスト104をマスクとしてCr層103をウェットエッチングする(図10(b))。ここで、フォトレジスト104の形状は、膜厚や現像後のベーク時間を調整し、テーパ角を30°~55°にする(後述する)。ウェットエッチングの方法は前述と同じである。次いで、Al-Nd合金層102をウェットエッチングする(図10(c))。エッチング液には、例えば、燐酸、硝酸、酢酸の混酸を用い、40~50℃の温度で行う。ウェットエッチングの方法としては特に制限はなく、シャワー処理あるいはディップ処理により実施することができる。次いで、Cr層101をドライエッチングする(図10(d))。エッチングガスとしては、Cl₂とO₂を用い、O₂によりフォトレジストをアッシングして後退させながらCr層103のひさし部及びCr層101を同時にエッチングし

た。エッチングのモードはPE、RIEのどちらであってもよい。フォトレジストのテーパ角を前述のように制御したことにより、 O_2 によるフォトレジストの後退が容易に行われる。最後に、フォトレジスト104を剥離除去し、信号線105(12)を形成した(図10(e))。

【0057】次に、高融点金属としてMo又はMoを主体とする合金を用いた場合について説明する。図11及び図12は、高融点金属としてMo又はMoを主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、図11は走査線を、図12は信号線を形成する工程を示す図である。

【0058】まず、走査線の形成方法について図11を参照して説明する。透明絶縁性基板31上に積層されたAl-Nd合金層91及び高融点金属層(Mo層)92上に、フォトレジスト93を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト93を所定のパターンにパターニングし(図11(a))、このフォトレジスト93をマスクとしてMo層92及びAl-Nd合金層91をウェットエッチングする(図11(b))。エッチング液には、

17
は、燐酸、硝酸、酢酸の混酸を用い、40～50の温度で行う。燐酸、硝酸、酢酸の組成は、MoのエッチングレートがAl-Nd合金のエッチングレートより速くなるように調整する。例えば、質量%比で、それぞれ72:4.4~5.4:8又は74:4.2~5.2:6の組成が望ましい。ウェットエッチングの方法としては、シャワー処理、ディップ処理のどちらでも可能だが、シャワー処理もしくはパドル処理又はディップ処理とシャワー処理との組合せで行うことが望ましい。最後に、フォトレジスト93を剥離除去し、走査線94(13)を形成した(図11(c))。

【0059】次に、信号線の形成方法について図12を参照して説明する。ゲート絶縁膜33上に積層された高融点金属層(Mo層)101、Al-Nd合金層102及び高融点金属層(Mo層)103上に、フォトレジスト104を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト104を所定のパターンにパターニングし(図12(a))、このフォトレジスト104をマスクとしてMo層103、Al-Nd合金層102及びMo層101をウェットエッチングする(図12(b))。エッチング液には、燐酸、硝酸、酢酸の混酸を用い、40～50の温度で行う。燐酸、硝酸、酢酸の組成は、質量%比で、それぞれ72:4.4~5.4:8又は74:4.2~5.2:6の組成のものを用いる必要がある。また、ウェットエッチングの方法としては、シャワー処理もしくはパドル処理又はディップ処理とシャワー処理との組合せで行うことが望ましい。走査線のような積層膜のエッチングはプロセスマージンが広いが、信号線のような3層の積層膜のエッチングは下層のMo層101がサイドエッチングされやすく、Mo層101、10

3、Al-Nd合金層102の膜厚に応じて、エッチング条件を最適化する必要がある。最後に、フォトレジスト104を剥離除去し、信号線105(12)を形成した(図12(c))。

【0060】次に、高融点金属としてMo又はMoを主体とする合金を用いた場合の他のエッチング態様について説明する。この態様は、信号線の形成方法に関するものである。図13は、高融点金属としてMo又はMoを主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、信号線を形成する工程を示す図である。

【0061】ゲート絶縁膜33上に積層された高融点金属層(Mo層)101、Al-Nd合金層102(Nd含有量0.5~1質量%)及び高融点金属層(Mo層)103上に、フォトレジスト104を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト104を所定のパターンにパターニングし(図13(a))、このフォトレジスト104をマスクとしてMo層103及びAl-Nd合金層102の途中までをウェットエッチングする。(図13(b))。エッチング液には、燐酸、硝酸、酢酸の混酸を用い、40～50の温度で行う。燐酸、硝酸、酢酸の組成は、MoのエッチングレートがAl-Nd合金のエッチングレートより速くなるように調整する。例えば、質量%比で、それぞれ72:4.4~5.4:8又は74:4.2~5.2:6の組成が望ましい。ウェットエッチングの方法としては、シャワー処理、ディップ処理のどちらでも可能だが、シャワー処理もしくはパドル処理又はディップ処理とシャワー処理との組合せで行うことが望ましい。次いで、残っているAl-Nd合金層102及びMo層101をドライエッチングする(図13(c))。Al-Nd合金層102のエッチングガスとしては、 Cl_2 と BCl_3 を用い、前述した条件で、また、Mo層101のエッチングガスとしては、 Cl_2 と O_2 を用い、2ステップでRIEを行う。最後に、フォトレジスト104を剥離除去し、信号線105(12)を形成した(図13(d))。

【0062】次に、高融点金属としてTi、TiN、Ta、Nb、Wの何れか又はこれらの何れかを主体とする合金を用いた場合について説明する。図14及び図15は、高融点金属としてTi、TiN、Ta、Nb、Wの何れか又はこれらの何れかを主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、図14は走査線を、図15は信号線を形成する工程を示す図である。

【0063】まず、走査線の形成方法について図14を参照して説明する。透明絶縁性基板31上に積層されたAl-Nd合金層91及び高融点金属層(Ti層又はTiN層、Ta層、Nb層、W層)92上に、フォトレジスト93を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト93を所定のパターンにパターニングし(図14(a))、このフォトレジスト93をマスクとしてTi

層（又はTiN層、Ta層、Nb層、W層）92及びAl-Nd合金層91をドライエッチングする（図14（b））。ここで、Al-Nd合金のNd含有量は、高融点金属がTi、Ta、Nbの場合、0.01%～1質量%であり、TiN、Wの場合、0.5～1質量%である。また、高融点金属がTi（合金）、TiN（合金）の場合、エッチングガスとしては、 Cl_2 と BCl_3 を用い、例えば、前述した条件で、1ステップでRIEを行う。また、高融点金属がTa（合金）、Nb（合金）、W（合金）の場合、高融点金属層92のエッチングガスとしては、 Cl_2 と O_2 又は4フッ化炭素（ CF_4 ）と O_2 を用い、また、Al-Nd合金層91のエッチングガスとしては、 Cl_2 と BCl_3 を用い、例えば、前述した条件で、2ステップでRIEを行う。なお、高融点金属がCr（合金）又はMo（合金）の場合は、前述したウェットエッチングを含むエッチング方法以外に、ここで示したようなドライエッチングも可能である。この場合、Cr（合金）、Mo（合金）のエッチングガスは Cl_2 と O_2 を用い、RIEを行えばよい。最後に、フォトレジスト93を剥離除去し、走査線94（11）を形成した（図14（c））。

【0064】次に、信号線の形成方法について図15を参照して説明する。ゲート絶縁膜33上に積層された高融点金属層（Ti層又はTiN層、Ta層、Nb層、W層）101、Al-Nd合金層102及び高融点金属層（Ti層又はTiN層、Ta層、Nb層、W層）103上に、フォトレジスト104を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト104を所定のパターンにパターニングし（図15（a））、このフォトレジスト104をマスクとしてTi層（又はTiN層、Ta層、Nb層、W層）103、Al-Nd合金層102及びTi層（又はTiN層、Ta層、Nb層、W層）101をドライエッチングする（図15（b））。ここで、Al-Nd合金のNd含有量は、高融点金属がTi、Ta、Nbの場合、0.01%～1質量%であり、TiN、Wの場合、0.5～1質量%である。また、高融点金属がTi（合金）、TiN（合金）の場合、エッチングガスとしては、 Cl_2 と BCl_3 を用い、例えば、前述した条件で、1ステップでRIEを行う。また、高融点金属がTa（合金）、Nb（合金）、W（合金）の場合、高融点金属層103、101のエッチングガスとしては、 Cl_2 と O_2 又は CF_4 と O_2 を用い、また、Al-Nd合金層102のエッチングガスとしては、 Cl_2 と BCl_3 を用い、例えば、前述した条件で、3ステップでRIEを行う。尚、高融点金属がCr（合金）又はMo（合金）の場合は、前述したウェットエッチングを含むエッチング方法以外に、ここで示したようなドライエッチングも可能である。この場合、Cr（合金）、Mo（合金）のエッチングガスは Cl_2 と O_2 を用い、RIEを行えばよい。最後に、フォトレジスト104を剥離除去し、信号

線105（12）を形成した（図15（c））。以上のようにエッチングを行うことにより、配線電極形状を順テーパないしは階段形状に制御することができる。

【0065】次に、上記TFT基板10の上に、印刷により厚さ約50nmの配向膜39を形成し、約220の温度で焼成し、配向処理を行う。一方、透明絶縁性基板41上に、TFT基板10上の各画素領域に対応してカラーフィルタ42と、TFT部を含む画素領域の周辺部にブラックマトリクス43とが形成され、その上にITO等の透明導電膜からなる共通電極44が形成された対向基板40の上に、印刷により厚さ50nmの配向膜39を形成し、約220の温度で焼成し、配向処理を行う。これらのTFT基板10と対向基板40とを、エポキシ系樹脂接着剤からなるシール45及びプラスチック粒子等からなる面内スペーサー（図示せず）を介して、各々の膜面が対向するようにして所定間隔に重ね合わせる。その後、TFT基板10と対向基板40との間に液晶46を注入し、液晶46を注入したシール45の空間部（図示せず）をUV硬化型アクリレート系樹脂からなる封孔材（図示せず）で密閉する。最後に、TFT基板10と対向基板40の膜面とは反対側の面に、それぞれ偏向板47を貼って、液晶表示パネルを完成する。（図3（f））

【0066】この後、図示してないが、走査線端子14と信号線端子15上に駆動回路に接続するテープキャリアパッケージ（TCP）を圧接し、液晶表示装置を完成する。

【0067】前述の実施例では、5枚のマスクを用いてTFT基板を製造する場合について説明したが、本発明の液晶表示装置の製造方法は、4枚のマスクを用いてTFT基板を製造する場合にも適用可能である。本発明の第2の実施形態の液晶表示装置に用いられるTFT基板の製造方法は、（1）透明絶縁性基板上にゲート電極及び走査線を形成する工程、（2）ゲート絶縁膜、ソース、ドレイン電極及び信号線、半導体層を形成する工程、（3）パッシベーション膜、コンタクトホールを形成する工程、（4）画素電極を形成する工程を有し、前記ゲート電極及び走査線をAl-Nd合金層と高融点金属層との積層構造に形成し、前記ソース、ドレイン電極及び信号線を高融点金属層とAl-Nd合金層と高融点金属層との3層構造に形成することを特徴とする。

【0068】本発明の液晶表示装置において用いられるTFT基板の製造方法の第2の実施例は、図5に示すように、まず、厚さ0.7mmの無アルカリガラスからなる透明絶縁性基板31上に、スパッタにより厚さ約200nmのAl-Nd合金層211と厚さ約100nmの高融点金属層212を成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、ゲート電極21、走査線（図示せず）、蓄積容量電極（図示せず）、遮光層（図示せず）、走査線端子部の下層金属膜32を形成する（図5

(a))。ここで、高融点金属の種類とAl-Nd合金のNd含有量については、第1の実施例と全く同様である。エッチングの方法についても前述した通りである。

【0069】次に、プラズマCVDにより厚さ約400nmのシリコン窒化膜からなるゲート絶縁膜33と厚さ約200nmのアモルファスシリコン(a-Si)層221と厚さ約30nmのリンをドーブしたN型アモルファスシリコン(n+a-Si)層222とを順次成膜し、さらに、スパッタにより厚さ約50nmの高融点金属層231と厚さ200nmのAl-Nd合金層232と厚さ約100nmの高融点金属層233を順次成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、ソース電極23、ドレイン電極24、信号線12、信号線端子部の下層金属膜34と半導体層22を形成する(図5(b))。ここで、高融点金属とAl-Nd合金のNd含有量については、前述した通りである。

【0070】本実施例では、第1の実施例と異なり、ソース、ドレイン電極と半導体層の形成を1工程で行う。この方法を図6を用いて説明する。図6は、図5(b)の工程を説明する断面図である。ゲート絶縁膜33、a-Si層221及びn+a-Si層222からなる3層膜上に積層された高融点金属層231、Al-Nd合金層232及び高融点金属層233上に、フォトレジストを塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト61を所定のパターンで階段形状にパターニングする。このとき、露光はハーフトーンマスク又はグレートーンマスクを用い、フォトレジスト61は、ソース、ドレイン電極となる部分でチャンネル領域に面する領域上だけ厚く形成し、ソース、ドレイン電極となる部分でその他の領域、信号線及び信号線端子部の下層金属膜上には薄く形成する。(図6(a))。次に、このフォトレジスト61をマスクとして高融点金属層231、Al-Nd合金層232及び高融点金属層233をエッチングする(図6(b))。エッチングの方法については前述した通りである。次に、酸素プラズマ処理を行い、フォトレジスト61を全体的にアッシングして、上記の薄い部分を除去する(図6(c))。次に、Nメチル2ピロリドン(NMP)のような有機溶剤の蒸気で残ったフォトレジスト62をリフローした後、このフォトレジスト63とソース、ドレイン電極、信号線及び信号線端子部の下層金属膜をマスクにして、n+a-Si層222及びa-Si層221をエッチングする(図6(d))。エッチングの方法は、例えば、SF₆とHeやSF₆とCl₂、H₂の混合ガス等、フッ素系ガス又はフッ素系ガスと塩酸(HCl)を除く塩素系ガスにより行われる。このエッチングはRIEで行なわれる。最後にフォトレジスト63を剥離除去した後、ソース電極23とドレイン電極24との間のn+a-Si層222をエッチングして除去して、ソース電極23、ドレイン電極24、信号線12及び信号線端子部の下層金属膜34を形成する(図6

(e))。チャンネル部分のn+a-Si層のエッチングの方法については、第1の実施例と同様である。n+a-Si層及びa-Si層のエッチングにHClを用いないことにより、Al-Nd合金のコロージョンを防止することができる。

【0071】次に、プラズマCVDにより厚さ約200nmのシリコン窒化膜からなるパッシベーション膜35を成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、画素部コンタクトホール36及び端子部コンタクトホール37を開口する(図5(c))。

【0072】次に、スパッタにより厚さ約50nmのITOまたはIZOからなる透明導電膜を成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、画素電極27及び端子部の接続電極38を形成する(図5(d))。透明導電膜のエッチングについては、第1の実施例と同様である。また、透明導電膜がITOである場合の成膜の方法についても、第1の実施例と同様である。最後に、約270℃の温度でアニールし、TFT基板を完成する。

【0073】この後、第1の実施例と同様にして、液晶表示装置を完成する。

【0074】前述の2つの実施例では、5枚又は4枚のマスクを用いた逆スタガチャネルエッチ型TFT基板を製造する場合について説明したが、本発明の液晶表示装置の製造方法は、逆スタガチャネル保護型TFT基板を製造する場合にも適用可能である。本発明の第3の実施形態の液晶表示装置に用いられるTFT基板の製造方法は、(1)透明絶縁性基板上にゲート電極及び走査線を形成する工程、(2)ゲート絶縁膜、a-Si層、チャネル保護膜を形成する工程、(3)ソース、ドレイン電極及び信号線、半導体層を形成する工程、(4)パッシベーション膜、コンタクトホールを形成する工程、(5)画素電極を形成する工程を有し、前記ゲート電極及び走査線をAl-Nd合金層と高融点金属層との積層構造に形成し、前記ソース、ドレイン電極及び信号線を高融点金属層とAl-Nd合金層と高融点金属層との3層構造に形成することを特徴とする。

【0075】本発明の液晶表示装置において用いられるTFT基板の製造方法の第3の実施例は、図8に示すように、まず、厚さ0.7mmの無アルカリガラスからなる透明絶縁性基板31上に、スパッタにより厚さ約200nmのAl-Nd合金層211と厚さ約100nmの高融点金属層212を成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、ゲート電極21、走査線(図示せず)、蓄積容量電極(図示せず)、遮光層(図示せず)、走査線端子部の下層金属膜32を形成する(図8(a))。ここで、高融点金属の種類とAl-Nd合金のNd含有量については、第1の実施例と全く同様である。エッチングの方法についても前述した通りである。

【0076】次に、プラズマCVDにより厚さ約400nmのシリコン窒化膜からなるゲート絶縁膜33と厚さ

約80nmのアモルファスシリコン(a-Si)層221と厚さ約100nmのシリコン窒化膜とを順次成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより、ゲート電極21に対向して、チャネル保護膜71を形成する。(図8(b))

【0077】次に、プラズマCVDにより厚さ約30nmのリンをドーブしたN型アモルファスシリコン(n+a-Si)層222と、さらに、スパッタにより厚さ約50nmの高融点金属層231と厚さ200nmのAl-Nd合金層232と厚さ約100nmの高融点金属層233とを順次成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより、ソース電極23、ドレイン電極24、信号線12、信号線端子部の下層金属膜34と半導体層22を形成する(図8(c))。ここで、高融点金属とAl-Nd合金のNd含有量については、前述した通りである。また、半導体層22のエッチングの方法は、第2の実施例と同様である。

【0078】次に、プラズマCVDにより厚さ約200nmのシリコン窒化膜からなるパッシベーション膜35を成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより、画素部コンタクトホール36及び端子部コンタクトホール37を開口する(図8(d))。

【0079】次に、スパッタにより厚さ約50nmのITOまたIZOからなる透明導電膜を成膜し、フォトリソグラフィとエッチングにより、画素電極27及び端子部の接続電極38を形成する(図8(e))。透明導電膜のエッチングについては、第1の実施例と同様である。また、透明導電膜がITOである場合の成膜の方法についても、第1の実施例と同様である。最後に、約270の温度でアニールし、TFT基板を完成する。

【0080】この後、第1の実施例と同様にして、液晶表示装置を完成する。

【0081】次に、本発明の根拠になるデータについて説明する。図16は、線幅6μm時のフォトレジストのテーパ角と現像後ベーク時間(温度145)との関係をグラフで示した一例である。フォトレジストの膜厚に応じ、現像後ベーク時間を約120秒以上にすれば、ほぼ一定のテーパ角が得られるようになり、膜厚が1.0μmのときは約33°、膜厚が1.5μmのときは約53°となる。テーパ角が小さいほど、CrとAl-Nd合金とCrの3層の積層膜のエッチング時に、図10(c)~図10(d)の工程において、フォトレジストの後退が容易になり、エッチング形状の制御が容易になる。配線幅が狭くなるにつれ、フォトレジストのテーパ角が大きくなり、エッチング時にフォトレジストが後退しにくくなるため、エッチング形状の制御が困難になる。特に配線幅が6μmより狭くなると、テーパ角を30°~35°程度に制御する必要がある。このためフォトレジストの膜厚を1.0μm程度にする必要がある。例えば、配線幅が16μmでは、フォトレジス

トの膜厚を1.5μmにしても、テーパ角は35°程度になり、エッチング形状の制御は容易である。従って、フォトレジストのテーパ角は30°~55°が望ましく、さらに望ましくは、30°~35°にするのがよい。

【0082】図17は、Al-Nd合金上に高融点金属を積層した場合のNd含有量とヒロック、比抵抗、ドライエッチ残渣の関係を表で示したものである。図17中、ヒロック及び残渣の発生についての評価は以下の通りである。

○：ヒロックは発生しない。

×：ヒロックが発生する。

また、エッチング時の残渣についての評価は以下の通りである。

○：残渣が発生しない。

○：残渣がわずかに発生する。

×：残渣が多く発生する。

【0083】ここで、Al-Nd合金の膜厚は250nm、高融点金属の膜厚は100nm、アニール温度は270~30分である。高融点金属がCr、Ti、Ta、Nbの場合は、Nd含有量が0.01質量%以上であれば、ヒロックは発生せず、また、高融点金属がMo、W、TiNの場合は、Nd含有量が0.5質量%以上であれば、ヒロックは発生しないことがわかった。一方、ドライエッチング時の残渣は、前述したエッチング条件で、0.01質量%~0.1質量%の範囲では発生はないが、0.5質量%~1.0質量%では残渣が僅かに発生した(問題とならないレベル)。しかし、2質量%では残渣が多く発生した。従って、高融点金属がCr、Ti、Ta、Nbの場合は、Al-Nd合金のNd含有量は0.01質量%~1.0質量%が望ましく、さらに望ましくは、0.01質量%~0.1質量%であればよい。また、高融点金属がMo、W、TiNの場合は、Al-Nd合金のNd含有量は0.5質量%~1.0質量%が望ましい。

【0084】図18は、MoとAl-Nd合金とMoの3層の積層膜のエッチング(図12参照)において、磷酸と酢酸を質量%比で72:8と74:6に固定した場合に、硝酸の濃度を变化させたときのエッチング形状の良否を表で示したものである。図18中、エッチング形状についての評価は以下の通りである。

○：下層のMoにサイドエッチが入らない。

×：下層のMoにサイドエッチが入る。

磷酸：酢酸=72:8のときは、硝酸が4.4質量%~5.4質量%の範囲で、また、磷酸：酢酸=74:6のときは、硝酸が4.2質量%~5.2質量%の範囲で、安定的に下層のMoにサイドエッチが入らない良好なエッチング形状が得られた。ここで、磷酸と酢酸の濃度を固定したのは、MoのエッチレートがAl-Nd合金のエッチレートの約2倍程度になる組成を選択したからで

ある。エッチング時にMoとAl-Nd合金の間に電極電位差に起因する電池が働くため、MoのエッチレートとAl-Nd合金のエッチレートがほぼ等しい領域では、Al-Nd合金層が大きくサイドエッチされることを確認した。従って、上記のエッチレートの関係になる領域で、硝酸の濃度を混合上限値から少なくしていき、エッチング形状が良好になる組成を見出した。(硝酸濃度の混合上限値は燐酸：酢酸=72:8のとき5.5質量%、燐酸：酢酸=74:6のときは5.3質量%である。)

【0085】図19は、ITOスパッタ時のH₂O分圧とITOと下層金属膜間のコンタクト抵抗、シュウ酸によるITOウェットエッチ時の残渣の関係を表で示したものである。ここでは、下層金属膜がCrの場合の値である。図19中、コンタクト抵抗についての評価は以下の通りである。

：コンタクト抵抗値はH₂Oを導入しない場合と同様である。

：コンタクト抵抗値はH₂Oを導入しない場合より少し高い。

x：コンタクト抵抗値はH₂Oを導入しない場合より非常に高い。

エッチング時の残渣についての評価は図17と同様である。H₂O分圧が 2×10^{-3} Pa以下では、コンタクト抵抗値はH₂Oを導入しない場合と同等であるが、H₂O分圧が 2×10^{-3} Paを超えると、徐々に上昇し、 5×10^{-2} Paを超えると急激に上昇することを確認した。H₂O分圧が 7×10^{-2} Paでは、コンタクト抵抗値は2桁程度上昇する。一方、シュウ酸によるITOウェットエッチ時の残渣は、H₂O分圧が 2×10^{-3} Pa以上では問題ないが、H₂O分圧が 6×10^{-4} Paでは、残渣が発生することを確認した。従って、ITOスパッタ時のH₂O分圧は、 2×10^{-3} Pa～ 5×10^{-2} Paの範囲内に制御することが望ましい。

【0086】以上のように、画素電極がパッシベーション膜上にある逆スタグ構造のTFT基板において、走査線と信号線にAl-Nd合金と高融点金属の積層膜を用い、高融点金属の種類に応じてNd含有量を最適値に調整することにより、ヒロックを抑制することができると共に、前述したエッチング方法を採用することにより、配線形状を順テーパ形状又は階段形状に制御することができる。また、前述した透明導電膜の成膜及びエッチング方法、チャネル部のn+a-Si及び半導体層のエッチング方法を採用することにより、信号線の断線やコロージョンを抑制することができる。

【0087】尚、前述した実施例ではツイステッドネマティック(TN)型の液晶表示装置に適用した例を示したが、本発明はインプレインスイッチング(IPS)型の液晶表示装置に適用できることは言うまでもない。IPS型液晶表示装置では、通常画素電極は金属膜で形成

*されるが、実施例に示したようなTFT基板では、端子部の接続電極や、共通配線の結束、保護トランジスタ部のゲート層とドレイン層との層変換のためにパッシベーション膜上の透明導電膜を使用するため、製造工程フローとしては、TN型もIPS型も全く同じになるためである。また、IPS型の液晶表示装置でも、開口率向上のため、パッシベーション膜上に透明導電膜で画素電極と共通電極を形成する技術があり、本発明は、このような液晶表示装置にも適用できることは明白である。また、前述した実施例ではa-Si TFTの例を示したが、ポリシリコン(p-Si)TFTにも適用できることは言うまでもない。

【0088】

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明によれば、TFT基板の配線形状の制御が容易で、エッチング残渣やヒロックの発生を抑制でき、また、信号線の断線やコロージョンの発生を低減できる低抵抗配線及び短縮プロセスを用いたTFT基板を容易に製造することができると同時に、透明導電膜と下層の金属膜とのコンタクト抵抗の増大を抑制でき、製品の歩留、信頼性を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の液晶表示装置に使用するTFT基板の構成を示す概念図である。

【図2】 本発明の第1の実施形態の液晶表示装置に使用するTFT基板の1画素部及び走査線端子部、信号線端子部の平面図である。

【図3】 本発明の第1の実施形態の液晶表示装置に使用するTFT基板の製造工程を図示したものであり、図2のA-A線、B-B線及びC-C線に沿って切って図示した断面図である。

【図4】 本発明の第2の実施形態の液晶表示装置に使用するTFT基板の1画素部及び走査線端子部、信号線端子部の平面図である。

【図5】 本発明の第2の実施形態の液晶表示装置に使用するTFT基板の製造工程を図示したものであり、図4のA-A線、B-B線及びC-C線に沿って切って図示した断面図である。

【図6】 図5(b)の工程を説明する断面図である。

【図7】 本発明の第3の実施形態の液晶表示装置に使用するTFT基板の1画素部及び走査線端子部、信号線端子部の平面図である。

【図8】 本発明の第3の実施形態の液晶表示装置に使用するTFT基板の製造工程を図示したものであり、図7のA-A線、B-B線及びC-C線に沿って切って図示した断面図である。

【図9】 高融点金属としてCr又はCrを主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、走査線を形成する工程を示す図である。

【図10】 高融点金属としてCr又はCrを主体とする

合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、信号線を形成する工程を示す図である。

【図11】高融点金属としてMo又はMoを主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、走査線を形成する工程を示す図である。

【図12】高融点金属としてMo又はMoを主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、信号線を形成する工程を示す図である。

【図13】高融点金属としてMo又はMoを主体とする合金を用いた場合の他の態様のエッチング処理の工程を示す図であり、信号線を形成する工程を示す図である。

【図14】高融点金属としてTi、TiN、Ta、Nb、Wの何れか又はこれらの何れかを主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、走査線を形成する工程を示す図である。

【図15】高融点金属としてTi、TiN、Ta、Nb、Wの何れか又はこれらの何れかを主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、信号線を形成する工程を示す図である。

【図16】線幅6μm時のフォトレジストのテーパ角と現像後バーク時間の関係をグラフで示した図の一例である。

【図17】Al-Nd合金上に高融点金属を積層した場合のNd含有量とヒロック、比抵抗、ドライエッチ残渣の関係を表で示した図である。

【図18】MoとAl-Nd合金とMoの3層の積層膜のエッチングにおいて、燐酸と酢酸を質量%比で72:8と74:6に固定した場合に、硝酸の濃度を变化させたときのエッチング形状の良否を表で示した図である。

【図19】ITOスパッタ時のH₂O分圧とITOと下層金属膜間のコンタクト抵抗、シュウ酸によるITOウェットエッチ時の残渣の関係を表で示した図である。

【符号の説明】

- 10 TFT基板
- 11 走査線
- 12 信号線
- 13 TFT
- 14 走査線端子
- 15 信号線端子
- 21 ゲート電極
- 22 半導体層
- 23 ソース電極

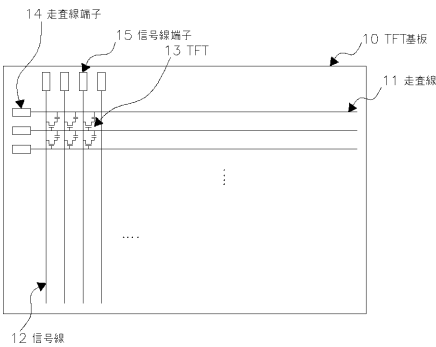
- *24 ドレイン電極
- 25 蓄積容量電極
- 26 遮光層
- 27 画素電極
- 31 透明絶縁性基板
- 32 走査線端子部の下層金属膜
- 33 ゲート絶縁膜
- 34 信号線端子部の下層金属膜
- 35 パッシベーション膜
- 36 画素部コンタクトホール
- 37 端子部コンタクトホール
- 38 接続電極
- 211 アルミニウム - ネオジウム層
- 212 高融点金属層
- 221 アモルファスシリコン層
- 222 N型アモルファスシリコン層
- 231 高融点金属層
- 232 アルミニウム - ネオジウム層
- 233 高融点金属層
- 39 配向膜
- 40 対向基板
- 41 透明絶縁性基板
- 42 カラーフィルタ
- 43 ブラックマトリクス
- 44 共通電極
- 45 シール
- 46 液晶
- 47 偏向板
- 61 フォトレジスト
- 62 フォトレジスト
- 63 フォトレジスト
- 71 チャネル保護膜
- 91 アルミニウム - ネオジウム層
- 92 高融点金属層
- 93 フォトレジスト
- 94 走査線
- 101 高融点金属層
- 102 アルミニウム - ネオジウム層
- 103 高融点金属層
- 40 104 フォトレジスト
- 105 信号線

*

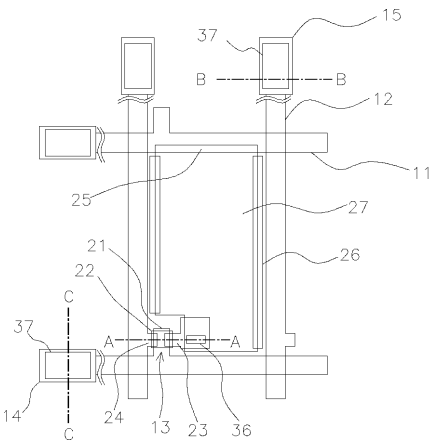
【図19】

H ₂ O分圧	6×10^{-4} Pa	2×10^{-3} Pa	5×10^{-2} Pa	7×10^{-2} Pa
コンタクト抵抗	○	○	△	×
ウェットエッチ残渣	×	○	○	○

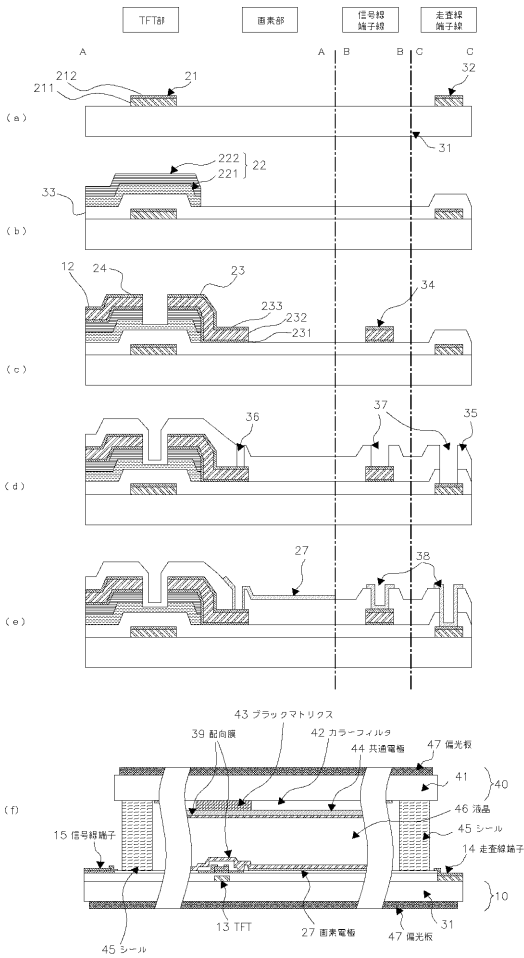
【図1】



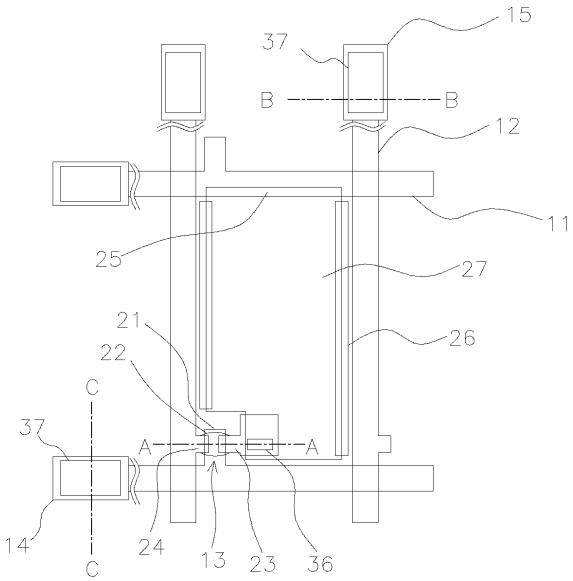
【図2】



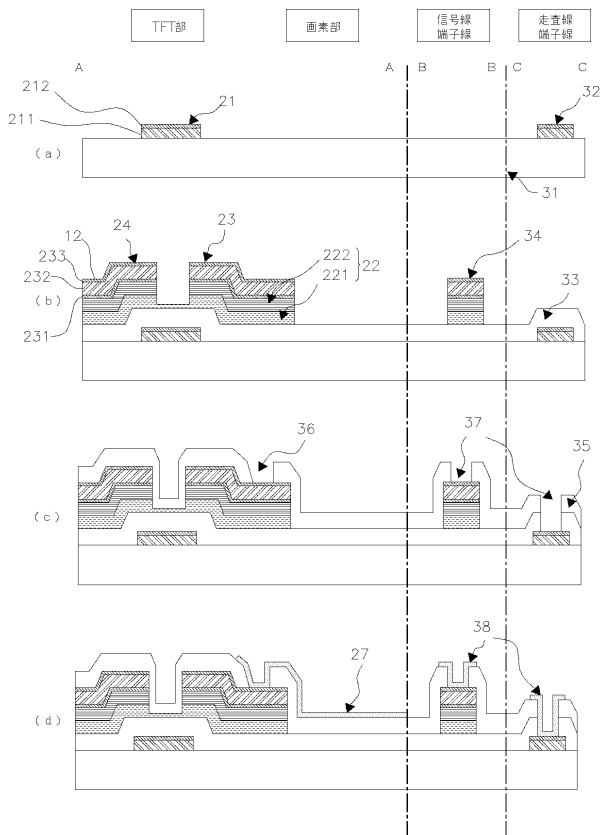
【図3】



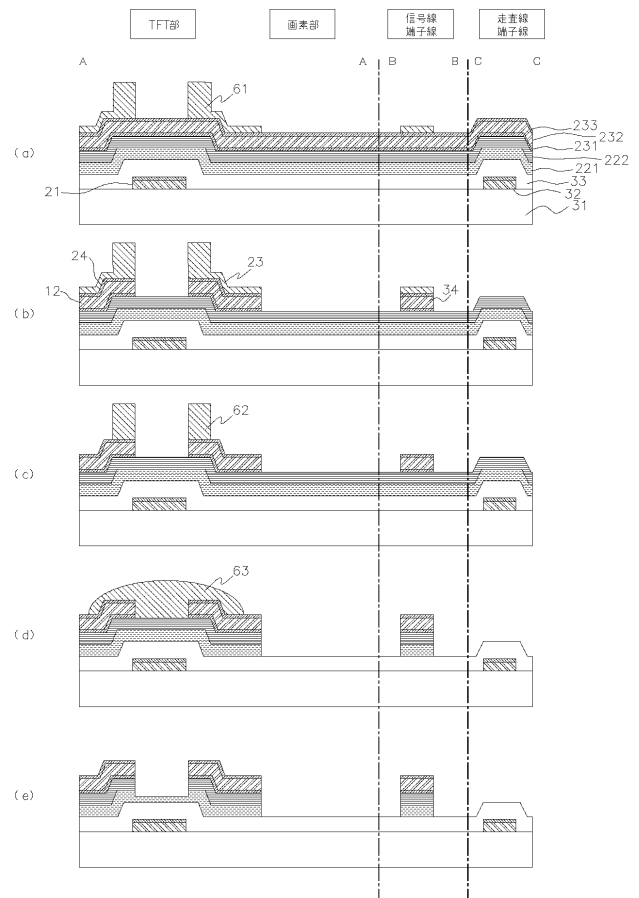
【図4】



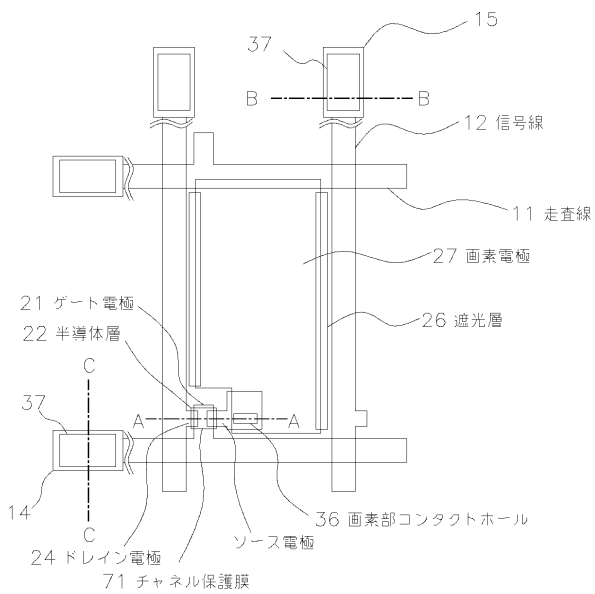
【図5】



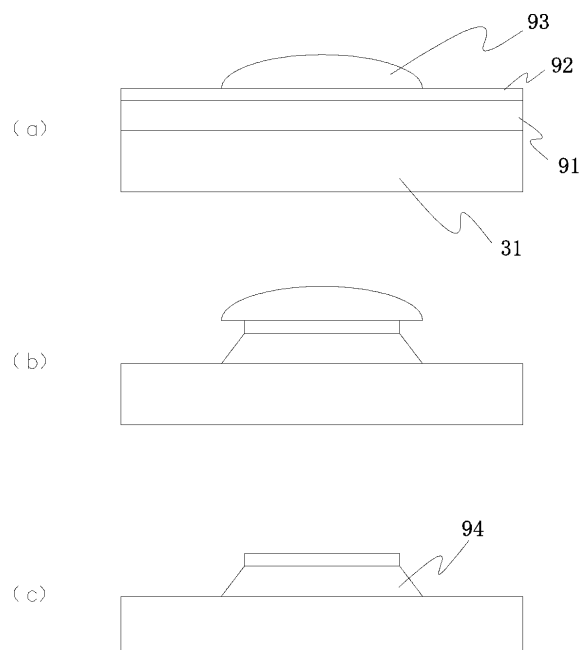
【図6】



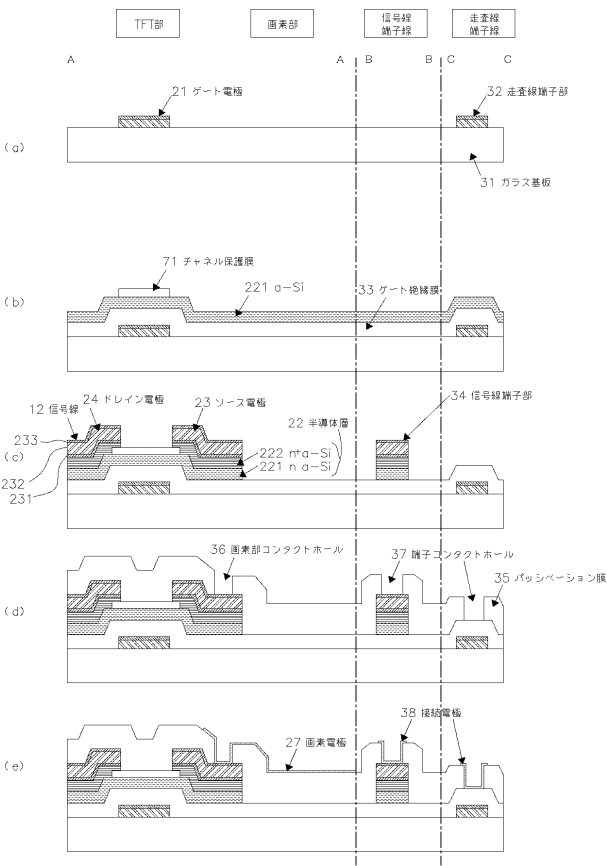
【図7】



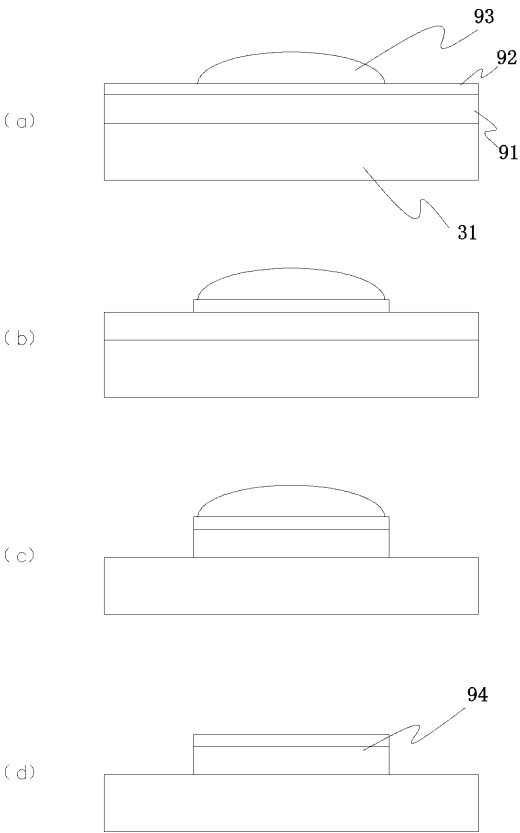
【図11】



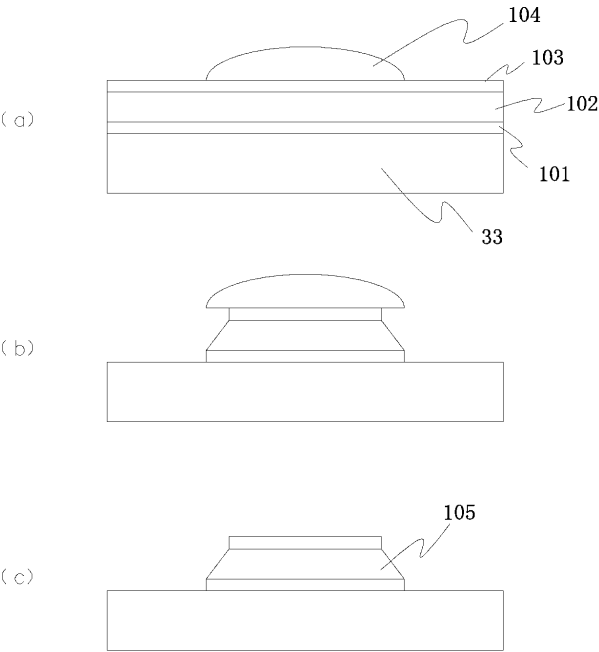
【図 8】



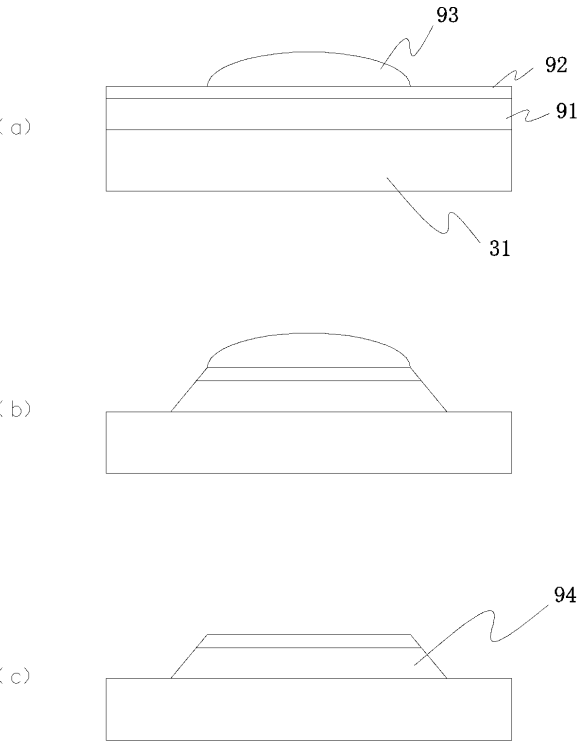
【図 9】



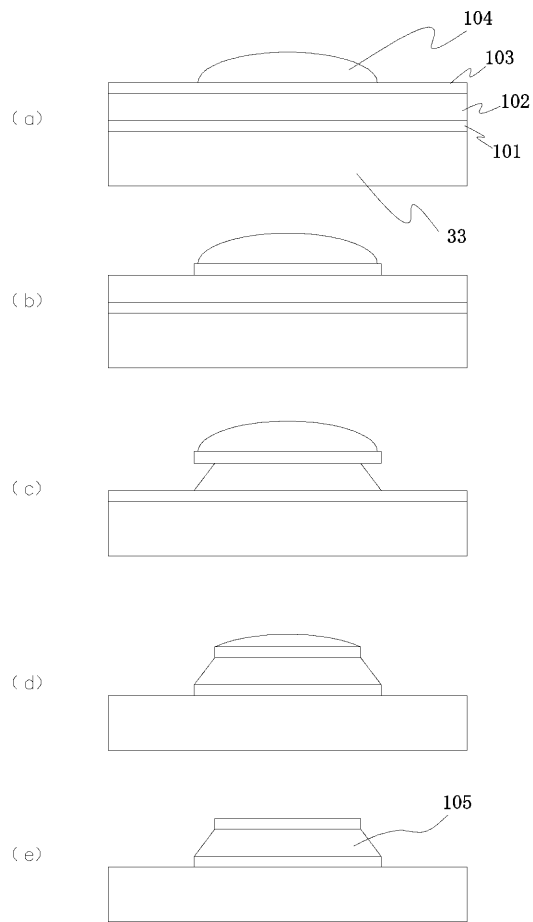
【図 12】



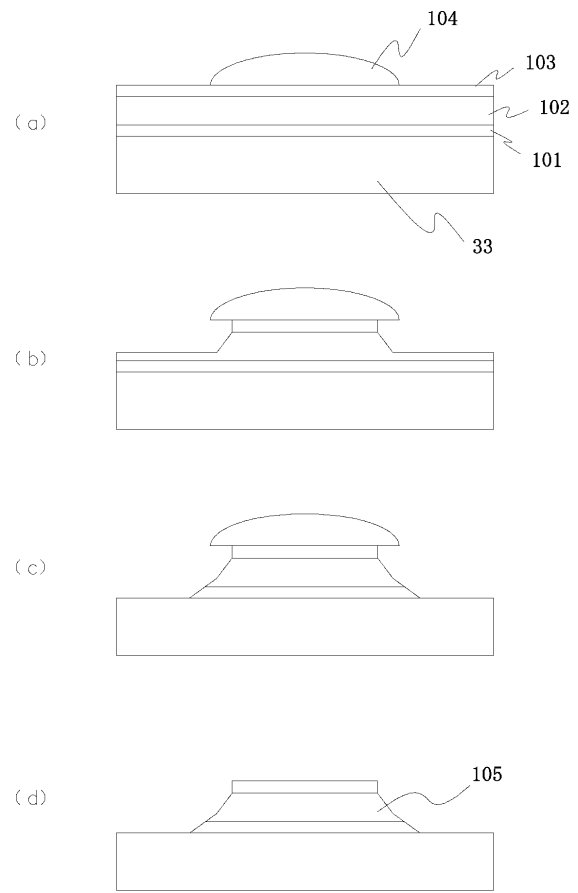
【図 14】



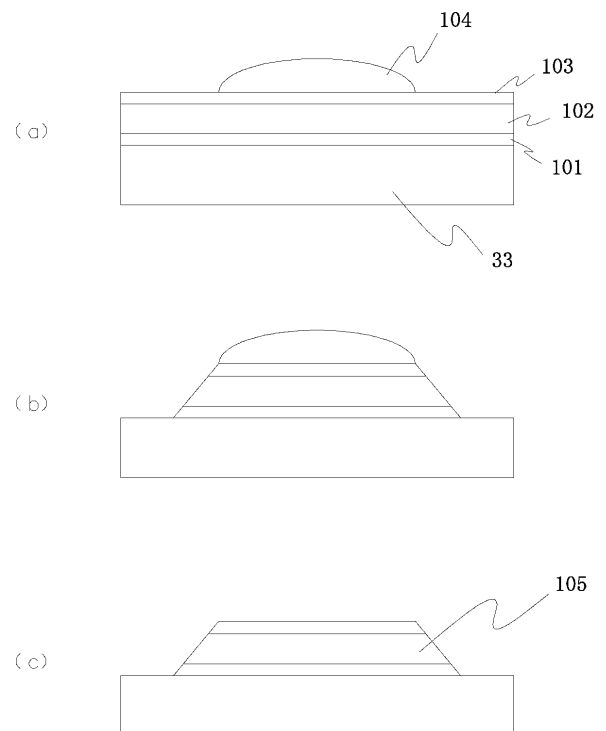
【図10】



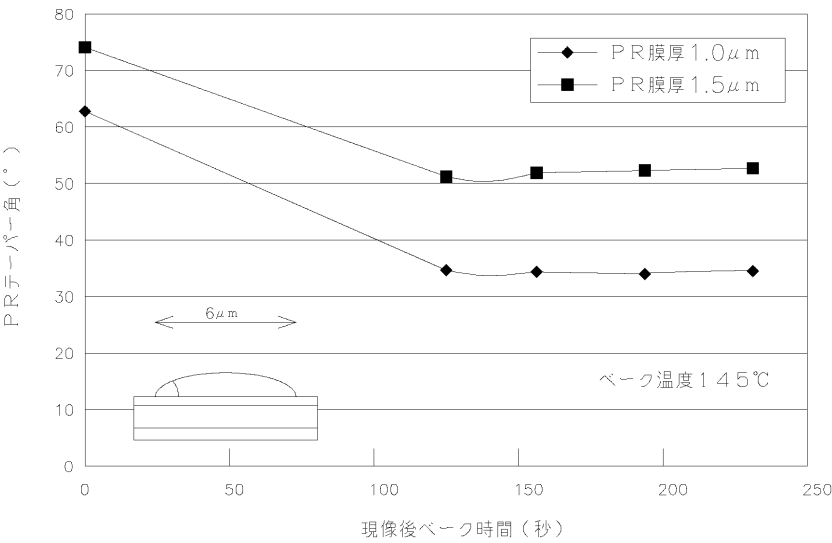
【図13】



【図15】



【図16】



【図17】

Nd濃度		0.01wt%	0.1wt%	0.5wt%	1.0wt%	2.0wt%
ヒロック	高融点金属					
	Cr,Ti,Ta,Nb	○	○	○	○	○
	Mo,W,TiN	×	×	○	○	○
比抵抗(μΩcm)		3.4	3.6	3.8	4.2	4.5
ドライエッチ残渣		○	○	△	△	×

【図18】

磷酸：酢酸=72：8(wt%)				
硝酸濃度	3.9wt%	4.4wt%	4.9wt%	5.4wt%
エッチング形状	×	○	○	○
磷酸：酢酸=74：6(wt%)				
硝酸濃度	3.7wt%	4.2wt%	4.7wt%	5.2wt%
エッチング形状	×	○	○	○

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード [*] (参考)
G 0 9 F 9/30	3 3 8	G 0 9 F 9/30	3 3 8 5 F 1 1 0
			5 G 4 3 5
H 0 1 L 21/28	3 0 1	H 0 1 L 21/28	3 0 1 L
21/306		29/78	6 1 2 C
21/3205		21/88	R
29/786		21/306	S
		29/78	6 1 6 U
			6 1 6 T

6 1 7 L

6 1 7 K

(72)発明者	田中 宏明	F ターム(参考)	2H092 JA24 JB24 JB33 KB04 KB05
	東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株		MA08 MA12 MA18 MA19 MA29
	式会社内		NA15 NA16 NA28 NA29
(72)発明者	木村 茂	4M104	AA09 BB02 BB38 BB39 CC01
	東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株		CC05 DD17 DD37 DD64 DD65
	式会社内		FF08 FF17 GG20 HH03
(72)発明者	木村 聡	5C094	AA42 AA43 BA03 BA43 CA19
	秋田県秋田市御所野下堤三丁目 1 番 1 号		DA13 EA04 EA07 FB12 JA01
	秋田日本電気株式会社内	5F033	GG04 HH10 HH17 HH18 HH19
			HH20 HH21 HH33 HH38 JJ38
			KK09 KK17 KK18 KK19 KK20
			KK21 KK33 LL02 LL09 MM05
			MM08 MM19 PP15 QQ08 QQ09
			QQ10 QQ13 QQ15 QQ20 QQ21
			QQ37 RR06 SS15 VV06 VV15
			WW00 WW04 WW05 XX16
		5F043	AA27 BB18 CC20 DD15 DD16
			DD27 EE07
		5F110	AA26 BB01 CC07 DD02 EE01
			EE04 EE06 EE14 EE23 EE44
			FF03 FF30 GG02 GG15 GG24
			GG45 HK01 HK04 HK06 HK09
			HK16 HK22 HK25 HK33 HK35
			HL07 NN02 NN24 NN72 NN73
			QQ04 QQ05
		5G435	AA17 BB12 CC09 HH12 KK05
			KK09 KK10

专利名称(译)	液晶显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP2002341367A	公开(公告)日	2002-11-27
申请号	JP2001150092	申请日	2001-05-18
申请(专利权)人(译)	NEC公司 秋田NEC公司		
[标]发明人	前田明寿 田中宏明 木村茂 木村聡		
发明人	前田 明寿 田中 宏明 木村 茂 木村 聡		
IPC分类号	G02F1/1343 G02F1/1333 G02F1/1362 G02F1/1368 G09F9/00 G09F9/30 G09F9/35 H01L21/28 H01L21/306 H01L21/3205 H01L21/77 H01L21/84 H01L23/52 H01L27/12 H01L29/45 H01L29/49 H01L29/786		
CPC分类号	G02F1/13458 G02F1/136286 G02F2001/13629 G02F2001/136295 H01L27/12 H01L27/124 H01L29/458 H01L29/4908		
FI分类号	G02F1/1343 G02F1/1368 G09F9/00.338 G09F9/00.342.Z G09F9/30.330.Z G09F9/30.338 G09F9/35 H01L21/28.301.L H01L29/78.612.C H01L21/88.R H01L21/306.S H01L29/78.616.U H01L29/78.616.T H01L29/78.617.L H01L29/78.617.K G02F1/13.101 G09F9/00.342 G09F9/30.330 H01L21/28.301.R		
F-TERM分类号	2H092/JA24 2H092/JB24 2H092/JB33 2H092/KB04 2H092/KB05 2H092/MA08 2H092/MA12 2H092/MA18 2H092/MA19 2H092/MA29 2H092/NA15 2H092/NA16 2H092/NA28 2H092/NA29 4M104/AA09 4M104/BB02 4M104/BB38 4M104/BB39 4M104/CC01 4M104/CC05 4M104/DD17 4M104/DD37 4M104/DD64 4M104/DD65 4M104/FF08 4M104/FF17 4M104/GG20 4M104/HH03 5C094/AA42 5C094/AA43 5C094/BA03 5C094/BA43 5C094/CA19 5C094/DA13 5C094/EA04 5C094/EA07 5C094/FB12 5C094/JA01 5F033/GG04 5F033/HH10 5F033/HH17 5F033/HH18 5F033/HH19 5F033/HH20 5F033/HH21 5F033/HH33 5F033/HH38 5F033/JJ38 5F033/KK09 5F033/KK17 5F033/KK18 5F033/KK19 5F033/KK20 5F033/KK21 5F033/KK33 5F033/LL02 5F033/LL09 5F033/MM05 5F033/MM08 5F033/MM19 5F033/PP15 5F033/QQ08 5F033/QQ09 5F033/QQ10 5F033/QQ13 5F033/QQ15 5F033/QQ20 5F033/QQ21 5F033/QQ37 5F033/RR06 5F033/SS15 5F033/VV06 5F033/VV15 5F033/WW00 5F033/WW04 5F033/WW05 5F033/XX16 5F043/AA27 5F043/BB18 5F043/CC20 5F043/DD15 5F043/DD16 5F043/DD27 5F043/EE07 5F110/AA26 5F110/BB01 5F110/CC07 5F110/DD02 5F110/EE01 5F110/EE04 5F110/EE06 5F110/EE14 5F110/EE23 5F110/EE44 5F110/FF03 5F110/FF30 5F110/GG02 5F110/GG15 5F110/GG24 5F110/GG45 5F110/HK01 5F110/HK04 5F110/HK06 5F110/HK09 5F110/HK16 5F110/HK22 5F110/HK25 5F110/HK33 5F110/HK35 5F110/HL07 5F110/NN02 5F110/NN24 5F110/NN72 5F110/NN73 5F110/QQ04 5F110/QQ05 5G435/AA17 5G435/BB12 5G435/CC09 5G435/HH12 5G435/KK05 5G435/KK09 5G435/KK10 2H088/FA10 2H088/FA19 2H088/HA02 2H088/HA08 2H088/JA05 2H088/MA20 2H192/AA24 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CB71 2H192/CC01 2H192/CC12 2H192/CC32 2H192/CC41 2H192/CC52 2H192/CC72 2H192/DA02 2H192/EA02 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/FA65 2H192/FB46 2H192/HA13 2H192/HA32 2H192/HA44 2H192/HA63 2H192/HA64 2H192/HA66 2H192/JA06 2H192/JA32		
代理人(译)	开宗明		
其他公开文献	JP4920140B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种液晶显示装置，其中在制造期间在布线中不出现小丘并且可以容易地控制蚀刻形状。 本发明的液晶显示装置包括：在基板上以矩阵状排列的扫描线，信号线，与扫描线和信号线连接的薄膜晶体管，以及与该薄膜晶体管连接的像素电极。 在液晶显示装置中，扫描线从下层起具有铝-钎合金层和难熔金属层的层叠结构，信号线从下层起具有难熔金属层，铝-钎合金层和难熔金属层。 钎含量根据难熔金属的种类进行调节。

